综合物理实验报告——光电传感器综合实验

物理 4+4 胡喜平 U201811966 hxp201406@gmail.com https://hxp.plus/

摘要:光电传感器是一种能将光信号转化为电信号的电子器件,在测量光强的方面有广泛的应用。本实验探究光敏电阻、硅光电池、光电二极管、光电三极管的特性。

关键词: 光电传感器、光敏电阻、硅光电池、光电二极管、光电三极管

一、引言

【实验目的】

将光敏电阻、硅光电池、光电二极管、光电三极管连入电路,用不同的光强照射,测量它们的性质。

二、实验内容与数据处理

【实验原理】

光敏电阻: 当光照射到光敏电阻上时,价电子迁移到导带,价带中留下空穴,导致电导率发生改变。电导率的变化为

$$\Delta \sigma = \Delta p \cdot e \cdot \mu_p + \Delta n \cdot e \cdot \mu_n$$

其中 Δp 是空穴浓度, Δn 是电子浓度, e 是电子电量, $\Delta \sigma$ 是电导率的变化, 其余为常数。

因此在没有光照的情况下,光敏电阻的电阻很大,有光照的情况下,光敏电阻的电阻小。在有光照的情况下,加电压生成**光电流**。

$$I_{ph} = \frac{A}{d} \cdot \Delta \sigma \cdot U$$

光照强度一定时,光电流和电压呈正比。电压一定时,光照强度越大,光电流越大。但是光照强度和 光电流不是线性关系,逐渐增大光照强度时,初期光电流迅速增加,后期光电流增加缓慢。

硅光电池: 硅光电池工作时,需要零偏或者反偏。当加入反偏电压 V 时

$$I = I_s \left[\exp\left(\frac{eV}{kT}\right) - 1 \right] + I_p$$

 I_s 是饱和电流, I_p 是光电流。当 V=0 时, $I=I_p$ 。实验中 V>0, $I=I_s-I_p$ 。其中光电流与光的功率的关系为

$$I_p = RP_i$$

P_i 为光的功率。

硅光电池的**短路电压、短路电流**为光电池直接串联电压表或电流表时测得的电压和电流。硅光电池 的**负载特性**为:低负载时电流大电压小,高负载时电流小电压大。

光敏二极管与三极管:在没有光照的条件下,光敏二极管和三极管的**饱和反向漏电流**小,称为暗电流。在有光的条件下,**饱和反向漏电流**大,且会随着电阻变化。此时光电流与偏压的关系成为伏安特性。

【实验内容】

- 测量光敏电阻的伏安特性曲线和光照特性曲线。
- 测量光敏二极管的伏安特性曲线和光照特性曲线。
- 测量**硅光电池**的伏安特性曲线和光照特性曲线。
- 测量光敏三极管的伏安特性曲线和光照特性曲线。

【实验结果的分析和结论】

【光敏电阻的伏安特性测量】

测量时串联的电阻为 981.3Ω

电源电压 (V)	2.002	4.002	6.002	7.002	8.000	10.009	12.005
电阻两端电压 (V)	0.2211	0.4438	0.6678	0.7803	0.8928	1.1203	1.3470

表 1: 光敏电阻伏安特性测量光照度 1003Lux

电源电压 (V)	2.0030	4.003	6.002	7.005	8.008	10.004	12.000
电阻两端电压 (V)	0.3641	0.7288	1.0958	1.2809	1.4665	1.8372	2.2107

表 2: 光敏电阻伏安特性测量光照度 2500Lux

电源电压 (V)	2.0028	4.000	6.009	7.0007	8.003	10.005	12.007
电阻两端电压 (V)	0.5054	1.0083	1.5192	1.7731	2.0271	2.5400	3.0558

表 3: 光敏电阻伏安特性测量光照度 5000Lux

电源电压 (V)	2.007	4.000	6.007	7.006	8.000	10.001	12.000
电阻两端电压 (V)	0.5995	1.9963	1.8001	2.1010	2.4011	3.0077	3.6160

表 4: 光敏电阻伏安特性测量光照度 7500Lux

【光敏电阻的光照特性测量】

测量时串联的电阻为 981.3Ω

光照强度 (Lux)	509	1002	1501	2000	2500	3000
电源电压 (V)	2.160	2.253	2.324	2.386	2.448	2.499
电阻两端电压 (V)	1.5823	0.2488	0.3224	0.3866	0.4450	0.4970

表 5: 光敏电阻光照特性测量光敏电阻两端电压 2V

光照强度 (Lux)	509	997	1503	2000	2500	3000
电源电压 (V)	4.316	4.499	4.652	4.775	4.887	4.999
电阻两端电压 (V)	0.3173	0.4965	0.6474	0.7768	0.8900	0.9963

表 6: 光敏电阻光照特性测量光敏电阻两端电压 4V

光照强度 (Lux)	509	1007	1498	2000	2500	3000
电源电压 (V)	6.476	6.752	6.973	7.166	7.338	7.502
电阻两端电压 (V)	0.4786	0.7531	0.9734	1.1696	1.3401	1.5013

表 7: 光敏电阻光照特性测量光敏电阻两端电压 6V

光照强度 (Lux)	504	1001	1501	2000	2500	3000
电源电压 (V)	8.625	8.999	9.303	9.559	9.801	10.011
电阻两端电压 (V)	0.6342	1.0016	1.3004	1.5637	1.7975	2.0095

表 8: 光敏电阻光照特性测量光敏电阻两端电压 8V

光照强度 (Lux)	504	1001	1499	2000	2500	3000
电源电压 (V)	10.804	11.256	11.627	11.956	12.254	12.510
电阻两端电压 (V)	0.7987	1.2554	1.6288	1.9584	2.2483	2.5132

表 9: 光敏电阻光照特性测量光敏电阻两端电压 10V

【硅光电池的伏安特性测量】

测量时取样电阻为 100Ω

负载电阻 (欧姆)	无穷	0	1000	2000	5100	7500	10000
光电压 (mV)	329.4	1.06	10.50	20.27	49.73	72.16	96.63

表 10: 硅光电池伏安特性测量光照度 503Lux

负载电阻 (欧姆)	无穷	0	1000	2000	5100	7500	10000
光电压 (mV)	362.5	1.89	20.38	39.32	96.03	138.18	181.21

表 11: 硅光电池伏安特性测量光照度 1003Lux

负载电阻 (欧姆)	无穷	0	1000	2000	5100	7500	10000
光电压 (mV)	379.9	2.84	30.56	58.97	143.3	201.99	253.54

表 12: 硅光电池伏安特性测量光照度 1495Lux

负载电阻 (欧姆)	无穷	0	1000	2000	5100	7500	10000
光电压 (mV)	391.7	3.79	41.07	79.26	189.56	257.23	304.8

表 13: 硅光电池伏安特性测量光照度 2000Lux

负载电阻 (欧姆)	无穷	0	1000	2000	5100	7500	10000
光电压 (mV)	400.1	4.74	51.35	99.03	231.20	298.90	336.0

表 14: 硅光电池伏安特性测量光照度 2500Lux

负载电阻 (欧姆)	无穷	0	1000	2000	5100	7500	10000
光电压 (mV)	406.10	5.81	61.53	118.16	267.14	327.60	355.5

表 15: 硅光电池伏安特性测量光照度 3000Lux

【硅光电池的光照特性测量】

【光电二极管的伏安特性测量】

测量时串联的电阻为 $1.002M\Omega$

【光电二极管的光照特性测量】

测量时串联的电阻为 $1.002M\Omega$

电源电压 (V)	0.6561	1.0113	2.0054	4.167	6.533	9.025	12.322
电阻两端电压 (mV)	135.23	135.81	137.00	138.14	138.85	140.000	140.30

表 16: 光电二极管伏安特性测量光照强度 506Lux

电源电压 (V)	0.6044	1.0094	2.011	4.127	6.554	9.273	12.325
电阻两端电压 (mV)	244.45	265.03	268.52	270.53	271.90	273.30	274.58

表 17: 光电二极管伏安特性测量光照强度 1008Lux

电源电压 (V)	0.6558	1.0215	2.093	4.117	6.552	9.219	12.312
电阻两端电压 (V)	0.5319	0.5403	0.5460	0.5507	0.5532	0.5562	0.5587

表 18: 光电二极管伏安特性测量光照强度 2000Lux

电源电压 (V)	0.8612	1.0227	2.032	4.124	6.534	9.201	12.314
电阻两端电压 (V)	0.7940	0.7965	0.8048	0.8120	0.8166	0.8204	0.8240

表 19: 光电二极管伏安特性测量光照强度 3000Lux

光照强度 (Lux)	504	1008	1503	2000	2500	3000
电源电压 (V)	2.136	2.271	2.405	2.540	2.674	2.800
电阻两端电压 (V)	0.137	0.271	0.405	0.540	0.674	0.804

表 20: 光电二极管光照特性测量光敏电阻两端电压 2V

	光照强度 (Lux)	497	1008	1498	2000	2500	3000
ſ	电源电压 (V)	4.138	4.274	4.406	4.544	4.684	4.807
	电阻两端电压 (V)	0.135	0.272	0.405	0.541	0.677	0.809

表 21: 光电二极管光照特性测量光敏电阻两端电压 4V

光照强度 (Lux)	497	1005	1499	2000	2500	3000
电源电压 (V)	6.138	6.264	6.409	6.537	6.679	6.811
电阻两端电压 (V)	0.135	0.273	0.4062	0.5440	0.6774	0.8110

表 22: 光电二极管光照特性测量光敏电阻两端电压 6V

光照强度 (Lux)	504	1000	1503	2000	2500	3000
电源电压 (V)	8.143	8.277	8.410	8.554	8.677	8.811
电阻两端电压 (V)	0.138	0.271	0.4088	0.5474	0.6804	0.8136

表 23: 光电二极管光照特性测量光敏电阻两端电压 8V

【光电三极管的伏安特性测量】

测量时串联的电阻为 $203.32k\Omega$

电源电压 (V)	1.02	3.020	5.04	7.01	9.00	15.13	17.4
电阻两端电压 (mV)	0.07	0.09	0.11	0.14	0.22	5.64	7.83

表 24: 光电三极管伏安特性测量光照强度 517Lux

电源电压 (V)	1.01	3.03	5.05	7.06	12.8	15.08	17.06
电阻两端电压 (mV)	0.13	0.16	0.20	0.26	2.61	5.58	7.55

表 25: 光电三极管伏安特性测量光照强度 1002Lux

电源电压 (V)	1.04	3.50	6.02	8.52	10.06	11.05	13.00
电阻两端电压 (V)	0.19	0.25	0.34	0.51	1.17	1.54	3.53

表 26: 光电三极管伏安特性测量光照强度 1505Lux

电源电压 (V)	1.05	3.03	5.01	7.04	9.03	11.01	13.06
电阻两端电压 (V)	0.05	0.07	0.08	0.12	0.19	1.58	3.59

表 27: 光电三极管伏安特性测量光照强度 2000Lux

【光电三极管的光照特性测量】

测量时串联的电阻为 $203.32k\Omega$

光照强度 (Lux)	505	1000	1505	2000	2500	3000
电源电压 (V)	2.02	2.03	2.04	2.06	2.07	2.09
电阻两端电压 (V)	0.02	0.03	0.04	0.06	0.07	0.09

表 28: 光电三极管光照特性测量光敏电阻两端电压 2V

光照强度 (Lux)	506	1005	1508	2000	2500	3000
电源电压 (V)	4.02	4.04	4.06	4.08	4.10	4.11
电阻两端电压 (V)	0.02	0.04	0.06	0.08	0.10	0.11

表 29: 光电三极管光照特性测量光敏电阻两端电压 4V

光照强度 (Lux)	506	1002	1498	2000	2500	3000
电源电压 (V)	6.03	6.05	6.08	6.10	6.13	6.15
电阻两端电压 (V)	0.03	0.05	0.08	0.10	0.13	0.15

表 30: 光电三极管光照特性测量光敏电阻两端电压 6V

光照强度 (Lux)	509	1001	1508	2000	2500	3000
电源电压 (V)	8.04	8.07	8.11	8.15	8.19	8.22
电阻两端电压 (V)	0.04	0.07	0.11	0.15	0.19	0.22

表 31: 光电三极管光照特性测量光敏电阻两端电压 8V

三、参考文献

综合物理实验讲义